

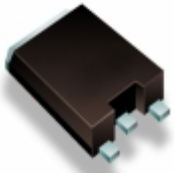

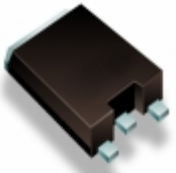





	<h2 style="color: red;">IRFBG30PBF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRFBG30PBF</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 1000V 3.1A TO-220AB</p> <p>Datenblätter: 1.IRFBG30PBF.pdf 2.IRFBG30PBF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 4021 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRFBG30PBF
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 1000V 3.1A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	4021 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	18 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 1000V 3.1A (Tc) 125W (Tc) Through Hole
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1000V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.1A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5 Ohm @ 1.9A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	80nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	980pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	*IRFBG30PBF

IRFBG30PBF ist neu im Original, Suche IRFBG30PBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFBG30PBF Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRFBG30PBF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IRFBL3703 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 260A SUPER D2PAK</p>	 <p>IRFBG30 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 1000V 3.1A TO-220AB</p>	 <p>IRFBL3315 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 150V 21A SUPER D2PAK</p>	 <p>IRFBG30PBF Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 1000V 3.1A TO-220AB</p>
 <p>IRFBG30 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 1000V 3.1A TO-220AB</p>	 <p>IRFBL10N60A IR IRFBL10N60A IR</p>	 <p>IRFBG20L Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 1000V 1.4A TO-262</p>	 <p>IRFBG20PBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 1000V 1.4A TO-220AB</p>

heiße Teile

Mehr

IRFBC40STRLPBF	IRFBC40STRLPBF	IRFBC40STRR	IRFBC40STRR	IRFBC41LC
IRFBE20PBF	IRFBE20PBF	IRFBE20SPBF	IRFBE30L	IRFBE30L
IRFBE30LPBF-M	IRFBE30PBF	IRFBE30PBF	IRFBE30SPBF	IRFBE30SPBF
IRFBE30STRLPBF	IRFBE30STRLPBF	IRFBF20LPBF	IRFBF20LPBF	IRFBF20STRL
IRFBF20STRL	IRFBF20STRLPBF	IRFBF20STRLPBF	IRFBG20PBF	IRFBG20PBF
IRFBG30PBF	IRFBL10N60A	IRFC480LCD	IRFD010PBF	IRFD010PBF
IRFD020PBF	IRFD020PBF	IRFD110PBF	IRFD110PBF	IRFD120PBF
IRFD120PBF	IRFD12N06RLESM	IRFD210PBF	IRFD210PBF	IRFD214PBF
IRFD214PBF	IRFD220PBF	IRFD220PBF	IRFD244PBF	IRFD310PBF
IRFD310PBF	IRFD320PBF	IRFD320PBF	IRFD9010	IRFD9010

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

